

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【公開番号】特開2006-229188(P2006-229188A)

【公開日】平成18年8月31日(2006.8.31)

【年通号数】公開・登録公報2006-034

【出願番号】特願2005-320856(P2005-320856)

【国際特許分類】

H 0 1 L 31/04 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 31/04 M

H 0 1 B 13/00 5 0 3 A

H 0 1 B 13/00 5 0 3 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月11日(2008.6.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 1】

本発明は、絶縁性基板の表面に形成された導電性薄膜の加工方法及び装置に関し、特に薄膜太陽電池の下部電極としてのモリブデン等の金属薄膜または上部電極としてのインジウム錫酸化物等の透明導電薄膜を加工する方法及び装置に関する。本発明の透明導電性薄膜は、太陽電池の受光面側電極としての利用の他、液晶表示パネル、プラズマ・ディスプレイ・パネル、有機 EL 素子など各種表示装置の透明性電極として、また、デフロスターの発熱体等として利用することができる。